

■共用ビームライン

No.	ビームライン名	研究分野	
実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）			
1	BL01B1 : XAFS I	広エネルギー領域 (3.8~113 keV)、希薄・薄膜試料のXAFS、クイックスキャンによる時分割XAFS（時分割QXAFS）、深さ分解XAFS、低温・高温XAFS、XAFS/XRD同時計測、XAFS/IR同時計測 XAFS測定装置、イオンチャンバー、ライトルーバー、19素子Ge検出器、転換電子収量検出器、2次元PILATUS検出器、電気炉 (1000 °C)、冷凍機 (4 K)、ガス供給除害設備、フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR) (4000 cm ⁻¹ ~ 500 cm ⁻¹) 偏向電磁石 (3.8~113 keV)	
2	BL02B1 : 単結晶構造解析	高分解能データによる精密構造解析、外場応答による構造相転移の探索、微小単結晶構造解析 半導体検出器 (BL02B1を初めて利用する場合や、持ち込みの装置がある場合 (温度可変や外場応答の実験) などは、利用申請に先立って事前にビームライン担当者との打合せを必要とする) 偏向電磁石 (8~70 keV)	
3	BL02B2 : 粉末結晶構造解析	電子密度レベルでの精密構造解析、構造相転移の研究、粉末回折データからの未知構造決定、リートベルト法による構造精密化、その場・オペランド粉末構造計測 (ガス溶媒雰囲気下など) 粉末回折計 (一次元半導体検出器)、大型デバイシェラーカメラ (イメージングプレート)、自動試料交換・自動測定 (50試料、90~1100 K)、二次元フラットパネル検出器 BL02B2を初めて利用する場合や、極低温条件 (冷凍機、>5 K)、高温条件 (電気炉: <1300 K、透過型高温ステージ: <1673 K)、ガス溶媒雰囲気下でのその場粉末X線回折実験などは、利用申請に先立って事前にビームライン担当者との打合せを必要とする。 偏向電磁石 (12~37 keV)	
4	BL04B1 : 高温高压	大容量プレスを用いた高温高圧下での結晶構造、物性測定 1500トンプレス (SPEED-1500、SPEED-Mk.II)、直流・交流抵抗加熱用電源、エネルギー分散型X線回折計、二次元X線CCD検出器、高速X線CCDカメラ、超音波速度測定システム 偏向電磁石 [白色20-150 keV、単色30-60 keV/Si(111)]	
5	BL04B2 : 高エネルギーX線回折	ガラス・液体・アモルファス物質の構造研究 ハイスループットPDF測定装置、自動試料交換・自動測定 (50試料、100~1,100 K)、窒素ガス吹付低温/高温装置、非晶質物質用二軸回折計、二次元フラットパネル検出器 (高温電気炉 (~1,300 K)、無容器式ガス浮遊炉 (1,200~3,200 K)、クライオスタット (20 K~室温)) 偏向電磁石 (Si 511: 113 keV, Si 220: 61.4 keV)	
6	BL08W : 高エネルギー非弾性散乱	磁気コンプトン散乱測定、高分解能コンプトン散乱測定、コンプトン散乱イメージング、高エネルギーX線回折、高エネルギーX線蛍光分析 (XRF)、時分割PDF解析 磁気コンプトン散乱スペクトロメータ、高分解能コンプトン散乱スペクトロメータ、高エネルギー蛍光X線スペクトロメータ、二次元フラットパネル検出器 橿円偏光ウェーブスレーパー (ステーションA: 110~300 keV、ステーションB: 100~210 keV)	
7	BL09XU : HAXPES I	共鳴硬X線光電子分光、偏光依存硬X線光電子分光、深さ分析した電子状態の研究、物性科学および応用材料科学 ・真空封止アンジュレータ (4.9~100 keV) ・ダブルチャンネルカットモノクロメータ(DCCM) : Si 220×2、Si 311×2 (hn=4.9-12 keV、連続波長掃引可能) / CCM : Si 333,444,555 (hn=6,8,10 keV 固定) ・ダブルダイヤモンドX線移相子：偏光切替 実験ハッチ1: 硬X線励起による高エネルギー分解能光電子分光 実験ハッチ2: 固体内部および界面電子状態の深さ分析 ・集光サイズ: 1.5 μm(V)×20 μm(H) (EH1)、1.5 μm(V)×11 μm(H) / 1.5 μm(V)×1 μm(H)* (EH2) (* 1 μm集光、および、走査マッピングを希望される際は担当者との事前打ち合わせが必要。) ・試料温度可能領域: 20~400 K程度 (冷却にはフロー型液体ヘリウムを使用)	

No.	ビームライン名	研究分野
	実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）	
8	BL10XU：高圧構造物性 ダイヤモンドアンビルセルを用いた高圧(<500 GPa)X線回折測定システム：X線フラットパネル検出器、イメージングプレート検出器、CdTe素子ハイブリッドピクセルアレイ検出器、イオンチャンバー、PINフォトダイオード検出器、X線集光レンズ、マルチチャンネルコリメータシステム、ラマン分光装置、ルビー圧力測定装置、高圧実験用クライオスタット(7~300 K)、レーザー加熱システム(1,500~6,000 K)、圧力印可用ガス圧制御装置 (CdTe素子ハイブリッドピクセルアレイ検出器、マルチチャンネルコリメータシステムの利用申請については事前にBL担当者にご連絡・ご相談ください) ・真空封止アンジュレータ (>6 keV) ・液体窒素冷却型標準二結晶モノクロメータ：Si 111反射 (~37 keV)、Si 220反射 (~61 keV)	ダイヤモンドアンビルセルを用いた高圧下でのX線結晶構造解析、複合極限環境下におけるその場/オペランド構造変化探索と圧縮挙動解明、高圧地球科学・惑星科学、高圧物質科学
9	BL13XU：X線回折・散乱 実験ハッチ1：多目的6軸X線回折計 実験ハッチ2：回折計測汎用フレーム 実験ハッチ3：高分解能粉末回折装置 実験ハッチ4：ナノビームX線回折装置 Si111/311分光結晶 実験ハッチ1：HUBER製 6軸回折計/C型 χ クレードル（試料4軸、検出器2軸）、試料ステージ（XYZ,スイベル）、ダブルスリット、ソーラースリット、アナライザ結晶、薄膜試料加熱装置（ AntonパールDHS1100、ADC XRD1500）、真空/N2/He/Al雰囲気 Si PIN フォトダイオード検出器、シンチレーション検出器、シリコンドリフト検出器、イメージングプレート、イオンチャンバー、一次元検出器(6連装MYTHEN)、二次元検出器 (PILATUS) 実験ハッチ2：ヘキサポッド付き試料ステージ、検出器保持用ロボットアーム、二次元検出器(PILATUS X 300K, PILATUS X 2M) EH2で持ち込み装置による実験をご希望の方は、申請前に担当者と打ち合わせること。 実験ハッチ3：大型二軸粉末回折計、高エネルギー対応6連装二次元検出器システム (Lambda 750K)、二次元フラットパネル検出器 (XRD1611, 400 x 400 mm ²)、自動試料交換・自動測定 (100試料、100~1100K)、オペランド計測用大型定盤 (θ , XYZ) , 窒素ガス吹付低温/高温装置、リモートガスハンドリングシステム EH3を初めて利用する場合や、BL常設の極低温条件（冷凍機）、高温条件（電気炉(Anton Paar)、高温ステージ(Linkam)：~ 1300 K, ~ 1700 K）、ガス溶媒雰囲気下でのその場粉末X線回折実験などは、利用申請に先立って事前にビームライン担当者との打合せを必要とする。 実験ハッチ4：ナノビームX線回折装置、フレネルゾーンプレート、X線屈折レンズ、二次元検出器(HyPix-3000、TimePix、CCDカメラ)、イオンチャンバー、Si PINフォトダイオード検出器、蛍光X線検出器 ・真空封止アンジュレータ (5~72 keV)	X線回折及び反射率測定、結晶表面界面・薄膜・ナノスケール材料の構造解析、残留応力測定、時分割X線回折測定、X線回折によるプロセス中その場観察、オペランドX線回折測定、結晶性材料の高分解能粉末回折およびX線全散乱測定、リートベルト法による構造精密化、その場・オペランド粉末構造測定および時分割X線回折測定（ガス溶媒雰囲気下など）、ナノビームX線回折による局所構造解析
10	BL14B2 : XAFS II X線イメージングカメラ、XAFS測定装置、イオンチャンバー、19素子Ge半導体検出器、7素子SDD検出器、ライトル検出器、転換電子収量検出器、クライオスタット (10 K~室温)、透過法用高温セル（室温~1000 °C）、蛍光法用高温セル（室温~800 °C）、ガス供給排気装置（申請にあたっては事前にビームライン担当者（本間）に連絡のこと） 偏向電磁石 (3.8~72 keV)	X線イメージング、広帯域XAFS測定(3.8~72 keV)、希薄・薄膜試料のXAFS測定、クイックスキャンによる時分割XAFS（時分割QXAFS）
11	BL19B2 : X線回折・散乱II ・多目的ハイスループット回折計（粉末回折装置）：窒素ガス吹付型低温（100~500 K）および高温（室温~1000 K）装置、試料自動交換ロボット ・多軸回折計：薄膜試料加熱装置（室温~1100 K），0次元検出器（シンチレーションカウンター、イオンチャンバー）、1次元検出器（6連装MYTHEN）、2次元検出器 (PILATUS 100K, 300K) ・小角X線散乱（極小角X線散乱）装置：カメラ長0.7, 2, 3, 40 m, 試料自動交換ロボット、温度変化装置（-190~400°C） 偏向電磁石 (6~72 keV)	残留応力測定、薄膜構造解析、表面、界面、粉末X線回折、X線トポグラフィ、小角X線散乱（極小角散乱）

No.	ビームライン名	研究分野
	実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）	
12	BL20XU：医学・イメージングII	<p>X線マイクロ/ナノイメージング：マイクロCT、ナノCT、屈折・位相コントラストイメージング、X線回折CT(XRD-CT)、マイクロビーム/走査型顕微鏡</p> <p>各種X線光学系・光学素子の研究開発・評価、コヒーレント光学実験</p> <p>極小角散乱</p> <p>イメージング用精密回折計、液体窒素冷却型標準二結晶モノクロメータ：Si111 (7.62~37.7 keV)、又は220 (~61 keV)、アンジュレータ中尺ビームライン(245m)、ビームサイズ：1.4 mm(H) x 0.7 mm(V) 於第一実験ハッチ、4 mm(H) x 2 mm(V) 於第二実験ハッチ)、高分解能画像検出器（分解能1 μm程度）、広視野イメージング/XRD用画像検出器（最大視野40mm、分解能10-20μm）、X線イメージインテンシファイア（Be窓、4インチ型）、試料準備用グローブボックス（露点-60度程度。リング棟外の下流ハッチに設置。通常Ar雰囲気で、必要に応じてN2雰囲気も使用可能：使用する場合、2週間以上前に担当者への事前連絡が必要）。</p> <p>マイクロCT、ナノCT (15-37.7keV)、XRD、マイクロビーム/走査型顕微鏡についてはこれらを組み合わせた計測も可能（マルチスケールCTまたは統合CT：要担当者と事前相談）</p> <p>USAXS (23keV, $3.6 \times 10^{-4} < q < 2.9 \times 10^{-3} [\text{1}/\text{\AA}]$, より小さいq値に関しては要担当者との相談)</p> <p>水平偏光真空封止アンジュレータ (7.62~61 keV)</p>
13	BL20B2：医学・イメージング	<p>micro-radiography、micro-angiography、micro-tomography、refraction-contrast imaging などが主として利用されている技術</p> <p>光学素子の評価やX線イメージングの基本技術の研究開発。</p> <p>汎用回折計、高分解能画像検出器(分解能10 μm程度)、大面積画像検出器(視野12 cm四方)</p> <p>中尺ビームライン (215 m)、最大ビームサイズ (300 mm(H) x 15 mm(V)；実験ハッチ2、3、60 mm(H) x 4 mm(V)；実験ハッチ1)</p> <p>偏向電磁石（標準分光器：8~113 keV、多層膜分光器：40 keV, 110 keV）</p>
14	BL25SU：軟X線固体分光	<p>光電子分光(PES)による電子状態の研究、角度分解光電子分光(ARPES)によるバンド構造の研究、軟X線吸収磁気二色性(MCD)による磁気状態の研究、光電子回折(PED)による表面原子配列の解析、低エネルギー電子／光電子顕微鏡(SPELEEM)による電子状態の顕微解析</p> <p>A ブランチ：阻止電場型分析器、光電子分光装置、低エネルギー電子／光電子顕微鏡装置。</p> <p>B ブランチ：磁気二色性測定装置。パルス磁場磁気二色性測定装置。ツインヘリカルアンジュレータ。（走査型XMCD顕微鏡は2022B期をもって共同利用を終了しました。）</p> <p>(Aブランチ：0.12~2 keV、Bブランチ：0.2~2 keV)。なお、以下[1]、[2]、[3]の場合には申請に先立ってビームライン担当者との打ち合わせを必要とする。</p> <p>[1]阻止電場型分析器を利用する場合、[2]持ち込み装置による実験を希望する場合、[3]パルス磁場磁気二色性装置を利用希望する場合。</p>
15	BL27SU：軟X線光化学	<p>部分蛍光収量法による希薄試料の軟X線吸収分光測定、深さ分解蛍光XAFS法による表面近傍の化学状態・電子状態分析、大気圧環境下での軟X線吸収分光測定、軟X線マイクロビームを用いた分光分析、軟X線発光分光による分析</p> <p>B ブランチ：Si(111)結晶分光器による高エネルギー軟X線 (2.1~3.3 keV) の利用、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軟X線吸収分光測定装置（電子収量法、部分蛍光収量法） ・蛍光X線分析装置 ・走査型軟X線顕微分光分析 <p>C ブランチ：回折格子分光器による低エネルギー軟X線 (0.17~2.2 keV) の利用、</p> <ul style="list-style-type: none"> ・軟X線吸収分光測定装置（電子収量法、部分蛍光収量法） ・軟X線発光分光測定装置 <p>・大気圧環境下での軟X線吸収分光測定（本装置の利用は、申請に先立って事前に担当者との打ち合わせを必要とする。）</p>
16	BL28B2：白色X線回折	<p>白色X線回折：X線トポグラフィ・エネルギー分散型ひずみ測定、高エネルギー (~200 keV) X線マイクロCT、高速X線イメージング</p> <p>白色X線トポグラフィ装置、多目的回折計、X線マイクロCT装置</p> <p>偏向電磁石（白色 5 keV~）</p> <p>ビームサイズ：50 mm(H) x 5 mm(V) @白色X線、50 mm(H) x 1.5 mm(V) @200 keV</p>

No.	ビームライン名	研究分野	
実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）			
17	BL35XU：非弾性・核共鳴散乱	非弾性X線散乱を用いた 固体フォノン及びガラス・液体の原子ダイナミクス。核共鳴非弾性散乱を利用した振動状態の研究、放射光メスバ 非弾性X線散乱 (~1 to 100 nm ⁻¹ 、12 アナライザ一分光器) 真空封止アンジュレータ（入射エネルギー：17.794、21.747 keV, エネルギー分解能 3.0、1.5 meV) ・集光サイズ：~Φ80 μm (KBミラー使用時 Φ20 μm) 核共鳴非弾性散乱分光装置：時間領域メスパワア分光装置：エネルギー領域メスパワア分光装置：準弾性散乱装置 ・真空封止アンジュレータ (14.4 - 27.8 keV、43.0 - 100 keV) ・集光サイズ：~50 (H) x 25 (V) μm @14.4 keV	
18	BL37XU：分光分析	X線マイクロ・ナノビームを用いた分光分析、X線イメージング、極微量元素分析、高エネルギー蛍光X線分析 投影型/走査型/結像型顕微XAFS、希薄・薄膜試料の高輝度XAFS、コヒーレントX線回折XAFS XAFS測定装置、走査型X線顕微鏡、結像型X線顕微鏡、X線CT装置、多目的回折計、蛍光X線分析装置、湾曲結晶蛍光分光器、X線シャッター イオンチャンバー、PINフォトダイオード、1素子Ge半導体検出器、7素子シリコンドリフト検出器、可視光変換型X線検出器（高速CMOSカメラ）、フラットパネル検出器、2次元ピクセル検出器 真空封止アンジュレータ、液体窒素冷却型二結晶モノクロメータ (Si(111) : 4.5~37.7 keV, Si(511) : 12~113 keV)、高調波除去Pt/Ruコートミラー（横はね、ペンド可） ビームサイズ：1 mm(H)×0.7 mm(V)、100 nm(H)×100 nm(V) (W.D. = 100 mm、5~55 keV)、500 nm(H)×300 nm(V) (W.D. = 300 mm、5~30 keV)	
19	BL39XU：磁性材料	X線磁気円二色性分光 (XMCD) および元素選択的磁化測定、X線発光分光 (XES) およびその磁気円二色性、マイクロ/ナノビームを用いた XMCD 磁気イメージング・微小領域・微小試料の XMCD および元素選択的磁化測定、高圧下での XAFS および XMCD 測定、水平・垂直直線または円偏光を用いた X線分光	
※2023B期募集なし			
19	ダイヤモンド円偏光素子(X線移相子、4.92~23 keVで使用可能) X線磁気円二色性(XMCD)測定装置+磁場発生装置[電磁石(3.5 T)、超伝導磁石(7 T, 2 K)] 4軸回折計(Huber 424 + 511.1)(*), X線発光分光装置(入射X線: 4.92~19 keV, 発光X線: 4.4~18 keV)(*、**) 低温装置[ヘリウムフロー型クライオスタット(11~500 K)、超伝導磁石(2~300 K)、パルスチューブ型冷凍機(4~300 K)(*)] 高圧発生装置(DAC、常圧~180 GPa@室温、常圧~40 GPa@低温)(* 高圧XMCD用KBミラー(集光ビームサイズ 縦2 μm × 横9 μm、W.D. = 400 mm、5~9.5 keV)(* 顕微XMCD、XAFS用KBミラー(集光ビームサイズ 100 nm~300 nm、W.D. = 80 mm、5~16 keV)(* (*) 利用希望の場合、課題申請時に担当者と事前に打ち合わせを必要とします (**) 一部、利用できないエネルギー領域があります		
20	BL40XU：高フラックス	高速時分割回折および散乱実験、X線光子相関分光法、蛍光X線分析、マイクロビームを用いた回折および散乱実験、微小単結晶構造解析 [第一ハッチ] X線シャッター、高速CMOSビデオカメラ(Orca-Flash 4.0 (浜松ホトニクス), FASTCAM Mini AX200(Photron), FASTCAM NovaS16 (Photron))、フラットパネル検出器 [第二ハッチ**] 精密回折計、ゾーンプレート集光光学系、フェムト秒レーザー、EIGER 1M *ヘリカルアンジュレータ (8~17 keV) *ビームサイズ(サンプル位置): 250 μm (H) x 40 μm (V) *フラックス 10 ¹⁵ photons/s (12 keV) *モノクロメータを用いず、準单色光($\Delta \lambda / \lambda = 2\%$)が使用可能 **初めて利用する場合や、持ち込みの装置がある場合などは、利用申請に先立って事前にビームライン担当者との打合せを必要とする	

No.	ビームライン名	研究分野
	実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）	
21	BL40B2 : SAXS BM 小角散乱カメラ（長さ；250、500、1000、1500、2000、3000、4000、6000(*) mm) 2次元ピクセルアレイ検出器 (Pilatus3S 2M, Pilatus100KS and Eiger2 S 500K Dectris社製, ModuPIX, ADVACAM社製) イメージングプレート検出器 (R-AXIS VII(*), Rigaku社製) X線イメージインテンシファイア(XII 4インチBe窓, Hamamatsu社製)(* 上記XIIのイメージカメラには、CCD(C4742-98(*), Hamamatsu社製) あるいはCMOS(C11440-22C(*), Hamamatsu社製)の選択が可能 フラットパネル検出器 (C9728DK-10, Hamamatsu社製; 広角測定用) 小角散乱-広角散乱切り替え装置 (SAXS: 1500, 2000, 3000, 4000 mm for Pilatus3 S 2M; WAXS: 85-170 mm for Eiger2 S 500K) 試料環境装置：温度制御 (Instec社製HCS302あるいはTS62、Linkam社製10002L、メトラー社製DSC FP84HT(*))、リガク社製DSC(*)）、加熱延伸装置 (Linkam社製10073L(*))、窒素ガス発生装置（最大流量5リットル/分）、溶液散乱用自動洗浄装置および液体試料チャンジャー(Xenocs社製Biocube(*)) 偏向電磁石 (6.5-22 keV)	X線小角散乱 (SAXS)
	(*) 利用希望の場合は、課題申請時にビームライン担当者と打ち合わせを必要とする。	
22	BL41XU : 生体高分子結晶解析 生体高分子結晶用回折装置 真空封止アンジュレータ（通常モード 6.5~17.7 keV、*高エネルギーモード 19~35 keV) ビームサイズ（試料位置）：4(H) × 5(V) μm ² ~ 22(H) × 45(V) μm ² (通常モード), 30 × 30 μm ² ~ 300 × 300 μm ² (高エネルギーモード) ピクセル検出器 EIGER X 16M(通常モード時), EIGER2 X CdTe 4M (高エネルギーモード時) 吹付け低温装置（窒素ガス ≥ 100 K、ヘリウムガス ≥ 20 K) ペルチェ冷却型シリコンドリフト検出器 凍結結晶自動交換装置SPACE * 高エネモードの利用を希望される場合は担当者まで課題申請前にご相談下さい。 2021B期より付帯設備としてクライオ電子顕微鏡 EM01CT(CRYO ARM 300)とEM02CT(CRYO ARM 200)を運用しています。 ご利用にあたっては下記Webサイトをご確認下さい。 http://stbio.spring8.or.jp	生体高分子X線結晶構造解析、微小結晶構造解析、超高分解能構造解析
23	BL43IR : 赤外顕微分光 波数域：150~10,000 cm ⁻¹ 高空間分解顕微鏡：対物鏡 (x36(NA=0.5, WD=10 mm), x15(NA=0.4, WD=24 mm), x20(ATR))、フロー式クライオスタッツ (4.2~400 K)、冷却加熱ステージ (-190~600°C) 長作動距離顕微鏡：対物鏡 x8(NA=0.5, WD=50 mm)、ダイヤモンドアンビルセル+フロー式クライオスタッツ (0.4 mmキュレット/30 GPa, 10~400 K)、フロー式クライオスタッツ (4.2~400 K) 磁気光学顕微鏡：対物鏡 (x16(NA=0.3, WD=40 mm)、最大磁場 ±14 T、フロー式クライオスタッツ (5~400 K)	

No.	ビームライン名	研究分野
実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）		
BL45XU : 生体高分子結晶解析II 生体高分子結晶用回折装置 真空封止アンジュレータ（6.5~16.0 keV） ビームサイズ（試料位置）：5(H) × 5(V) μm^2 ~ 50(H) × 50(V) μm^2 24 大型ピクセル検出器 PILATUS 6M 吹付け低温装置（窒素ガス ≥ 100 K） 凍結結晶自動交換装置SPACE ご利用にあたっては下記Webサイトをご確認下さい。 http://stbio.spring8.or.jp		
BL46XU : HAXPES II 真空封止アンジュレータ（5.5~37 keV、水平偏光） ダブルチャンネルカットモノクロメータ(DCCM) : Si 220×2、Si 311×2 第1実験ハッチ：汎用硬X線光電子分光装置 ・ Scienta Omicron製R4000-10kV、X線エネルギー：6, 8, 10 keV、ビームサイズ：1 $\mu\text{m}(V) \times 30 \mu\text{m}(H)$ 、トランスファーベッセル、試料加熱サンプルホルダー（RT~500 K）、電圧印加サンプルホルダー、電子中和錠、Ar+イオン銃（スペッタエッティング、帯電中和）、内部X線源（AlK α 、AgL α ） 第2実験ハッチ：大気圧硬X線光電子分光装置 ・ Scienta Omicron製R4000-10keV ・ Scienta Omicron製R4000-Hipp2、X線エネルギー：6, 8, 10 keV、ビームサイズ：1 $\mu\text{m}(V) \times 10 \mu\text{m}(H)$ 、ガス雰囲気下*での計測 *導入ガス種、ガス圧については事前に担当者とご相談下さい		
BL47XU : マイクロCT 真空封止アンジュレータ（5.2~37.7 keV、水平偏光） 26 高分解能X線CT装置、高速度X線撮影装置、硬X線マイクロビーム/走査型顕微鏡実験 実験ハッチ2：持込装置を設置するスペースあり これまで実施していない実験や新規利用の方は必ずビームライン担当者との事前打ち合わせを行ってください。		

■理研ビームライン

No.	ビームライン名	研究分野
実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）		
BL05XU : 施設開発ID I エネルギー範囲：7~15 keV, 27 フォトンフラックス： $<1 \times 10^{13}$ photons/s (12.4 keV) 試料一検出器間距離：~10 cm - 4 m その他の条件や設備については事前にBL担当者までご相談ください。		

No.	ビームライン名	研究分野
実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）		
28	BL07LSU : 施設開発ID II	<p>長尺アンジュレーター光を必要とする軟X線光学系開発</p> <p>6セグメントの水平及び垂直8の字アンジュレーター、エネルギー範囲 250~2000 eV (水平・垂直偏光)</p> <p>エネルギー分解能(設計値) $E/\Delta E > 10^4$</p> <p>ビーム高さ 1417 mm</p> <p>ビームサイズ >数 mm (後置鏡なし)</p> <p>フラックス >10^{11} ph/sec/0.01%BW</p> <p>BL07LSUへの共同利用申請の際には、事前にBL担当者（理研 大浦：oura@spring8.or.jp）との打ち合わせを必要とする。</p>
28	BL17SU : 理研 物理科学III	<p>◆走査型軟X線分光顕微鏡 --- A3 station 低真空～He大気圧下における試料表面の顕微分光観察</p> <p>◆汎用型光電子顕微鏡 --- Bc station 電子／磁気状態イメージング（分解能 100nm 未満）およびその時間分解測定</p> <p>ヘリカル8アンジュレータ、エネルギー範囲@ a & b ブランチ: 225* ~ 2,000 eV (*225 eV: 左右円偏光、272 eV: 水平偏光、136 eV: 垂直偏光) 、エネルギー分解能： $E/dE \sim 10,000$、ビームサイズ@試料位置：約30 μm(H) × 4 μm(V)</p> <p>BL17SUへの共同利用申請の際には、事前に以下の各実験装置担当者との打ち合わせを必要とする。</p> <p>走査型軟X線分光顕微鏡：JASRI／理研 菅 (hiroki-suga@spring8.or.jp) 、理研 大浦 (oura@spring8.or.jp)</p> <p>汎用型光電子顕微鏡：JASRI／理研 大河内 (o-taku@spring8.or.jp)</p> <p>装置持込みエリア：理研 大浦 (oura@spring8.or.jp)</p>
29	BL19LXU : 理研 物理科学II	<p>長尺アンジュレーター光を必要とする超高輝度X線物理科学研究</p> <p>実験ステーション/装置: 5(W) × 3.4(D) × 4.5(H) m³のオープンハッチ、光学定盤、PINフォトダイオード、シンチレーションカウンター、イオンチャンバー、ステッピングモータードライバーおよびコントローラー、NIMビン電源、カウンター、蓄積リングのRFに同期したトリガー信号</p> <p>光源(試料位置でのエネルギー範囲等): 真空封止アンジュレータ(7.1~18 keV、22~51 keV、フラックス:$\sim 10^{14}$ photons/s@12.4 keV)</p> <p>その他の条件や設備については事前にBL担当者までご相談ください。</p>
30	BL26B1 : 理研 構造ゲノムI	<p>X線結晶解析法に基づいた構造生物学研究</p> <p>二次元検出器(DECTRIS EIGER4M (BL26B1))、水平スピンドル軸ゴニオメータ、吹付低温装置(95 K～室温)、サンプルチェンジャーSPACE、偏向電磁石(6.5～15.5 keV)</p> <p>ご利用にあたっては下記Webサイトをご確認下さい。</p> <p>http://stbio.spring8.or.jp</p>
31	BL29XU : 理研 物理科学 I	<p>長尺ビームラインやコヒーレントX線を利用した物理科学研究</p> <p>実験ステーション/装置: 5(W) × 3(D) × 3.3(H) m³[ハッチ1]、10(W) × 4.25(D) × 4.5(H) m³[ハッチ2]、8(W) × 4(D) × 3.3(H) m³[ハッチ3]、6(W) × 3(D) × 3.3(H) m³[ハッチ4]のオープンハッチ、光学定盤、PINフォトダイオード、シンチレーションカウンター、イオンチャンバー、ステッピングモータードライバーおよびコントローラー、NIMビン電源、カウンター、可視光変換型X線カメラ、蓄積リングのRFに同期したトリガー信号</p> <p>光源(試料位置でのエネルギー範囲等): 真空封止アンジュレータ(一次光: 5~19 keV、三次光: 15~56 keV、フラックス: $\sim 6 \times 10^{13}$ photons/s@10 keV)、シリコン分光器(4.4 ~ 37.8 keV)</p> <p>その他の条件や設備については事前にBL担当者までご相談ください。</p>

No.	ビームライン名	研究分野
	実験ステーション/装置 光源（試料位置でのエネルギー範囲等）	
32	BL32XU：理研 ターゲットタンパク 実験ステーション/装置 EEMミラー集光ユニット、超低偏心・高精度ゴニオメータ、極低温He吹付け装置、高感度高速X線PAD検出器 (Dectris社 EIGER X 9M)、ハンプトンビン対応大容量試料交換ロボット 光源（試料位置でのエネルギー範囲等） : [光源]ハイブリッドアンジュレータ [試料位置でのビームサイズ] 1~10 ミクロノーマー [1ミクロノーマーのフラックス] 7×10^{10} photons/sec. @12.4 keV [利用可能なエネルギー範囲] 9~18 keV (9 keVより低エネルギー（長波長）を利用希望の場合には担当者までご連絡ください) ご利用にあたっては下記Webサイトをご確認下さい。 http://stbio.spring8.or.jp	{研究分野：構造生物学、生体高分子X線結晶構造解析、超微小結晶構造解析
33	BL36XU：理研 物質科学II [エネルギー領域] 4.5-35 keV、[ビームサイズ] $40\text{ }\mu\text{m(V)} \times 500\text{ }\mu\text{m(H)}$ 、100 nm(V)×100 nm(H)、[時間分解能] クイックXAFS (20 ms) [光源、光学素子] 真空封止テーパーアンジュレータ、チャネルカット結晶分光器(Si(111), Si(220))、鉛直・水平集光Rh/Ptコートミラー、Rh/PtコートKBミラー(4.5-35 keV) [計測システム] 透過法XAFS計測システム、25素子Ge検出器、4素子SDD検出器、PILATUS 300KW、4素子Merlin検出器、可視光変換型X線イメージ検出器 共用利用可能な装置は、クイックXAFS装置のみです。共用枠での利用申請の際には、必ず、事前にビームライン担当にご相談ください。	{テーパーアンジュレータ光を用いた時間分解クイックXAFS
34	BL38B1：理研 構造生物学 偏向電磁石(6.5~15.5 keV) *利用は12.4 keVまたは15.5 keVのみ 小角散乱カメラ長；300、2,500 mm 二次元検出器(DECTRIS PILATUS3X 2M)、SEC-SAXS用島津製HPLC *利用課題はBioSAXS限定	{小角X線散乱測定
35	BL43LXU：理研 量子ナノダイナミクス [エネルギー領域] 14.4-26 keV (基本波) [スペクトロメータ] 高分解能スペクトロメータ (meV、原子ダイナミクス)	{meVスケールX線非弾性散乱による原子ダイナミクス
36	BL44B2：理研 物質科学I 波長: 0.41~0.8 Å 装置: 2軸粉末回折計 (2θレンジ: 0.5~153°, 2θステップ: 0.01°) 温度: -180~800°C	{全散乱による周期・非周期系の構造解析